


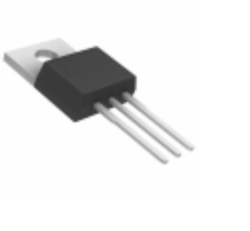





	<h2 style="color: red;">FDP10N60NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP10N60NZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP10N60NZ.pdf 2.FDP10N60NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28663 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP10N60NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28663 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 10A (Tc) 185W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	185W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1475pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP10N60NZ ist neu im Original, Suche FDP10N60NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP10N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP10N60NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP120AN15AO VB FDP120AN15AO VB</p>	 <p>FDP11N50 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p>FDP120AN15AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>
 <p>FDP10AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p>FDP10AN06AO Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDP100N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p>FDP120AN15AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP054N10	➡ FDP060AN08AO	➡ FDP060AN08AO	D FDP060AN08AO	➡ FDP060N08AO
⚡ FDP060N08AO	⚙ FDP068AN08AO	D FDP070AN06AO	➡ FDP070AN06AO	➡ FDP070AN06AO
⚙ FDP075N15A	⚡ FDP075N15A	⚙ FDP083N15A	➡ FDP083N15A	➡ FDP083N15A_F102
D FDP085N10A	⚙ FDP085N10A	⚡ FDP085N10A_F102	⚙ FDP090N10	➡ FDP090N10
➡ FDP100N10	➡ FDP100N10	⚙ FDP10AN06AO	⚡ FDP10AN06AO	➡ FDP10AN06AO
➡ FDP10N60NZ	➡ FDP120AN15AO	D FDP120AN15AO	⚙ FDP120AN15AO	⚡ FDP120N10
⚙ FDP120N10	D FDP12N50	➡ FDP12N50	➡ FDP12N50NZ	➡ FDP12N50NZ
⚡ FDP12N60NZ	⚙ FDP12N60NZ	➡ FDP13AN06AO	➡ FDP13AN06AO	➡ FDP13AN06AO
⚙ FDP14AN06LAO	⚡ FDP14AN06LAO	⚙ FDP14AN06LAO	D FDP14N60	➡ FDP150N10
➡ FDP150N10	⚙ FDP150N10A	⚡ FDP150N10A	⚙ FDP150N10A_F102	➡ FDP15N40

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited